NEC 電子部品 ELECTRONIC COMPONENTS

2SD412

TN－5236
MAY－30－75

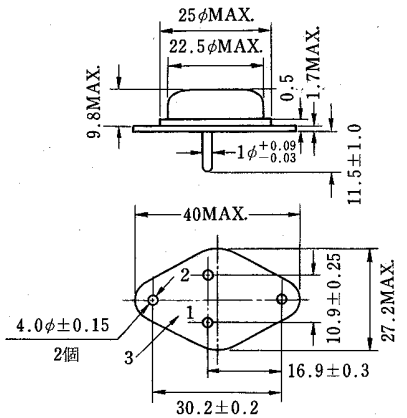
NPNエピタキシアルメサ形 シリコントランジスタ(ダーリントン接続)
低周波電力増幅および低速度スイッチング
通信工業用

○ダーリントン接続であるため直流電流増幅率が高い。

○コレクタ飽和電圧が低い。

○パルスモータドライバー，リレードライバー等にICの出力から直接ドライブする用途に最適です。

外形図／Outline（Unit：mm）

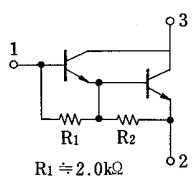


絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings（Ta＝25℃）

項　　目	略　号	定　　格	単　位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	100	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	10	V
コレクタ電流	$I_{C(DC)}$	15	A
コレクタ電流	$I_{C(pulse)}$*	20	A
ベース電流	$I_{B(DC)}$	1.5	A
全損失（T_C＝25℃）	P_T	100	W
コレクタしゃ断電流	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−65～＋150	℃

＊PW≦10ms，duty cycle≦50%

電極接続



$R_1 \fallingdotseq 2.0k\Omega$
$R_2 \fallingdotseq 150\Omega$

1. Base
2. Emitter
3. Collector（Case）

EIAJ　：TC-3，TB-3
JEDEC：TO-3
IEC　：C14A，B18

電気的特性／Electrical Characteristics（Ta＝25℃）

項　　目	略　号	条　　件	MIN.	TYP.	MAX.	単　位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CB}＝100V，I_E＝0			100	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	V_{CE}＝2.0V，I_C＝15A　＊	1000	4000		
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C＝15A，I_B＝30mA　＊			1.5	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	I_C＝15A，I_B＝30mA　＊			2.2	V

＊パルス測定／pulsed　　PW＝350μs，duty cycle≦2%